

半 导 体 学 报

第 6 卷 第 5 期 1985 年 9 月

目 录

- 硅及硅化钼超精细结构的刻蚀 李建中 I. Adesida E. D. Wolf (451)
- MOS 界面态电荷瞬态谱方法 郑心奋 李志坚 (458)
- GaAs 体效应器件中阴极深凹槽掺杂分布引起的静止畴的电场的计算分析
..... 郑一阳 (469)
- GaAs 体效应器件中阴极深凹槽引起的静止畴的实验研究 郑一阳 (475)
- 珀耳帖效应对无序绝缘衬底上多晶硅激光再结晶的影响 柳承恩 (481)
- FLOTOX 型 EEPROM 存贮管的擦写特性与理论分析
..... 朱 钧 靳东明 熊大菁 李志坚 (487)
- 中子辐照 P 型硅中的空穴陷阱和与氢有关的深能级中心
..... 杜永昌 张玉峰 孟祥提 (495)
- 红外瞬态退火全离子注入 MOS 工艺的研究
..... 侯东彦 马腾阁 陈必贤 钱佩信 (503)
- H₂O 在 Si(100)-(2×1) 表面上的吸附和氧化 邢益荣 W. Ranke (511)
- 无定形锗硅合金的光电特性 李长健 徐温元 (518)
- Al 在 InP(110) 面上的吸附 徐至中 (523)
- 用喇曼光谱测注硼硅片的损伤分布 吴华生 劳浦东 邬建根 屈逢源 (528)
- 半导体四层漏光波导的分析 II: 强耦合近似与精确解 张敬明 (536)

研 究 简 报

- 非晶硅隙态密度的场效应测量分析方法 连建宇 廖显伯 郑秉茹 孔光临 (545)
- 分子束外延 GaAs 中的 Sn 受主态 忻尚衡 L. F. Eastman (552)
- 不同气氛中生长 VPE-GaAs 的深中心 王健强 吴孝慎 李名复 林耀望 (556)

研 究 快 报

- 离子注入抗蚀技术 韩阶平 王培大 马俊如 王守武 (561)